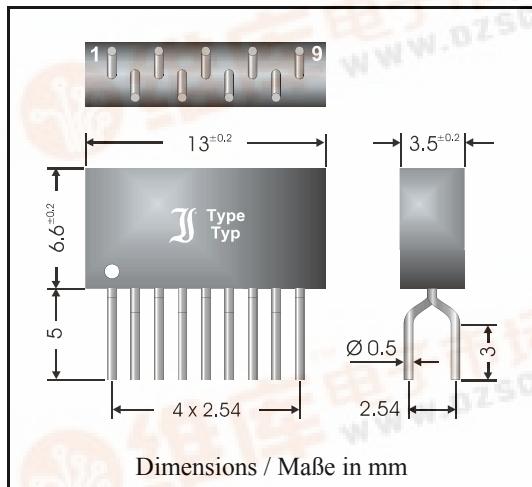


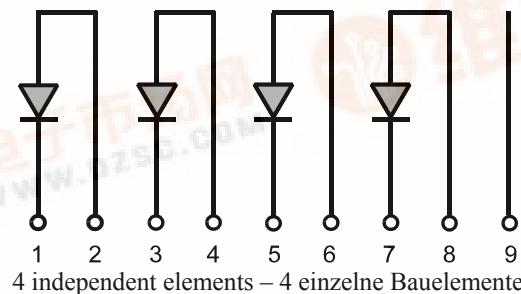
DAN 403 (200 mW)

Small Signal Diode Arrays

Dioden Sätze mit Allzweckdioden



Nominal power dissipation Nenn-Verlustleistung	200 mW
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	80 V
9 Pin-Plastic case 9 Pin-Kunststoffgehäuse	13 x 3.5 x 6.6 [mm]
Weight approx. Gewicht ca.	0.6 g
Standard packaging: bulk Standard Lieferform: lose im Karton	see page 22 s. Seite 22



Maximum ratings

Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
DAN 403	80	80

Max. average forward rectified current, R-load,
for one diode operation only
per diode for simultaneous operation

$T_A = 25^\circ C$

I_{FAV} 100 mA¹⁾
 I_{FAV} 50 mA¹⁾

Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last,
für eine einzelne Diode
pro Diode bei gleichzeitigem Betrieb

$T_U = 25^\circ C$

I_{FAV} 100 mA¹⁾
 I_{FAV} 50 mA¹⁾

Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwelle

$T_A = 25^\circ C$

I_{FSM} 500 mA

Operating junction temperature – Sperrsichttemperatur
 Storage temperature – Lagerungstemperatur

T_j – 50...+150°C
 T_s – 50...+150°C

Characteristics	Kennwerte			
Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 10 \text{ mA}$	V_F	< 1.0 V
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = 20 \text{ V}$	I_R	< 25 nA
Reverse recovery time Sperrverzug	$I_F = 10 \text{ mA}$ through/über $I_R = 10 \text{ mA}$ to/auf $I_R = 1 \text{ mA}$		t_{rr}	< 4 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrsicht – umgebende Luft			R_{thA}	< 85 K/W ¹⁾

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
 Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden